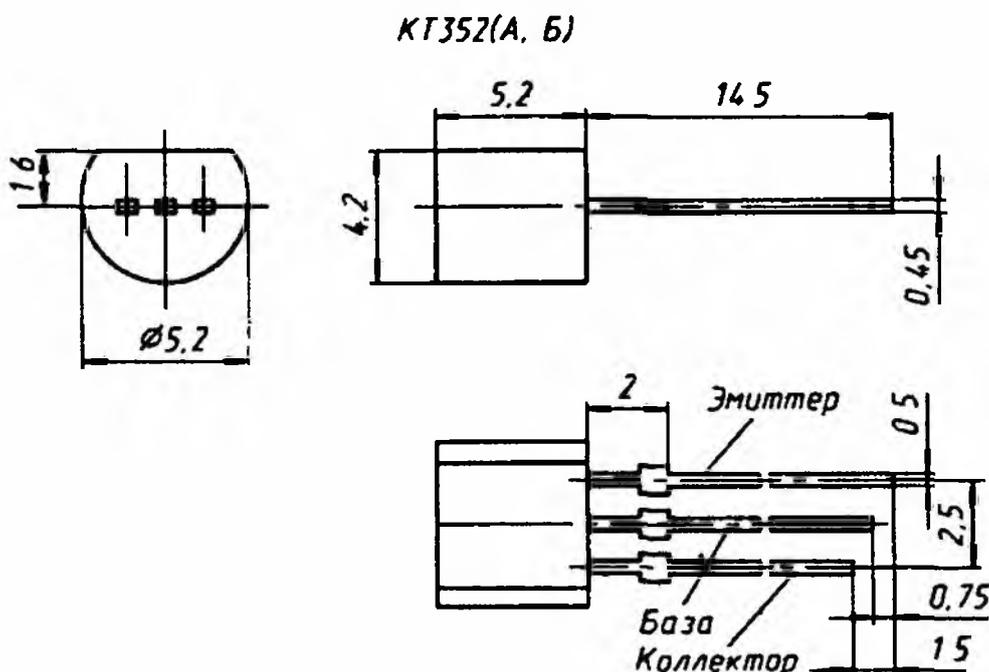


## КТ352А, КТ352Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры  $p-n-p$  усилительные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На корпусе наносится условная маркировка двумя цветными точками: КТ352А — зеленой и розовой, КТ352Б — зеленой и желтой.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Изготовитель — завод полупроводниковых приборов, г. Рига.



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КБ} = 1$  В,  $I_3 = 200$  мА:

$T = +25$  °С:

КТ352А ..... 25...65\*...120

КТ352Б ..... 70...115\*...300

$T = -40$  °С, не менее ..... 0,3 значения при  $T = +25$  °С

$T = +85$  °С ..... От 0,9 до 2 значений при  $T = +25$  °С

Граничная частота коэффициента передачи

тока при  $U_{КБ} = 5$  В,  $I_3 = 10$  мА, не менее ..... 200 МГц

типичное значение ..... 450\* МГц

|  |         |
|--|---------|
| Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 200$ мА, $I_b = 20$ мА для КТ352А, $I_b = 3$ мА для КТ352Б, не более ..... | 0,6 В   |
| типичное значение .....  | 0,37* В |
| Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 200$ мА, $I_b = 20$ мА для КТ352А, $I_b = 3$ мА для КТ352Б, не более .....      | 1,1 В   |
| типичное значение .....  | 0,81* В |
| Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 10$ В, не более:   |         |
| $T = +25$ °С .....   | 1 мкА   |
| $T = +85$ °С .....   | 10 мкА  |
| Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4$ В, не более .....   | 10 мкА  |
| Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5$ В, не более .....  | 15 пФ   |
| типичное значение .....  | 9,5* пФ |
| Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 1$ В, не более .....  | 30 пФ   |
| типичное значение .....  | 20* пФ  |

### Предельные эксплуатационные данные

|  |              |
|--|--------------|
| Постоянное напряжение коллектор—база .....                             | 20 В         |
| Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{бэ} \leq 10$ кОм ..... | 15 В         |
| Постоянное напряжение эмиттер—база .....                               | 5 В          |
| Импульсный ток коллектора при $t_n \leq 1$ мкс, $Q \geq 10$ .....      | 200 мА       |
| Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> :             |              |
| при $T \leq +30$ °С .....  | 300 мВт      |
| при $T = +85$ °С .....   | 162,5 мВт    |
| Тепловое сопротивление переход—среда .....                             | 0,4 °С/мВт   |
| Температура р-п перехода .....   | +150 °С      |
| Температура окружающей среды .....                                     | -40...+85 °С |

<sup>1</sup> В диапазоне температур +30...+85 °С допустимое значение рассеиваемой мощности снижается линейно.

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм.

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса 5 мм при температуре не выше +250 °С и длительности не более 10 с. Температура корпуса при пайке не должна превышать +150 °С.